

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета РТЭ Небольсин В.А.
«27» марта 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«Микроэлектроника и оптоэлектроника»

Направление подготовки 16.03.01 Техническая физика

Профиль Физическая электроника

Квалификация выпускника бакалавр

Нормативный период обучения 4 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2024

Автор программы  Коротков Л.Н.

Заведующий кафедрой
Твердотельной электроники  Небольсин В.А.

Руководитель ОПОП  Янченко Л.И.

Воронеж 2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Изучение студентами современного состояния и перспективных направлений развития полупроводниковой и функциональной микроэлектроники, ее элементной базы, методов проектирования и расчета основных структур интегральных микросхем и их практического использования

1.2. Задачи освоения дисциплины

Дать представление о фундаментальных физических процессах, лежащих в основе оптической и квантовой электроники, рассмотреть принцип действия, особенности конструкций, требования к активным материалам и элементам, возможности и технические характеристики приборов и устройств оптической электроники, подготовить будущих специалистов к теоретически грамотному их применению и дальнейшему изучению специальной литературы по отдельным вопросам данной отрасли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Микроэлектроника и оптоэлектроника» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Микроэлектроника и оптоэлектроника» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-4 - Способность осуществлять разработку и контроль технологических процессов изготовления оптических и оптико-электронных, материалов, узлов и устройств

ПК-6 - Способность осуществлять разработку и контроль технологических процессов изготовления материалов, узлов и устройств микроэлектроники и квантовой электроники на базе нанотехнологий

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-4	<u>Знать</u> основы технологии материалов оптических и оптико-электронных, материалов, узлов и устройств.
	<u>Уметь</u> критически оценивать достоинства, недостатки и области возможного применения новых научных и технических разработок, реализованных в различных типах электронных приборов, лазеров, фотоизлучателей и фотоприемников.
	<u>Владеть</u> навыками практического исследования приборов и устройств оптоэлектроники.
ПК-6	<u>Знать</u> основы технологических процессов изготовления материалов, узлов и устройств

	микроэлектроники и квантовой электроники на базе нанотехнологий.
	<u>Уметь</u> выполнять критический анализ результатов исследований в области микроэлектроники и квантовой электроники.
	<u>Владеть</u> представлением о месте электроники, оптической и квантовой электроники в современной науке и технике, и областях применения соответствующих приборов.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Микроэлектроника и оптоэлектроника» составляет 9 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры	
		6	7
Аудиторные занятия (всего)	180	90	90
В том числе:			
Лекции	90	54	36
Практические занятия (ПЗ)	54	18	36
Лабораторные работы (ЛР)	36	18	18
Самостоятельная работа	117	54	63
Курсовой проект	+	+	
Часы на контроль	27	-	27
Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет с оценкой	+	+	+
Общая трудоемкость:			
академические часы	324	144	180
зач.ед.	9	4	5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего, час
1	Введение. Виды классификации интегральных микросхем	Введение. История микроэлектроники. Виды классификации интегральных микросхем.	2	-	-	6	8
2	Общие сведения о планарно-	Общие сведения о	2	2	-	6	10

	эпитаксиальной технологии полупроводниковых интегральных микросхем.	планарно-эпитаксиальной технологии полупроводниковых интегральных микросхем.					
3	Биполярные интегральные микросхемы.	Разновидности биполярных интегральных транзисторов. Вертикальные и горизонтальные n- p-p и p-p-p транзисторы. Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы, транзисторные структуры для схем с инжекционным питанием. транзисторы с диодом Шоттки. Составные транзисторы, комплементарные пары. Аналоговые схемы на биполярных транзисторах. Типовые схемы усилительных каскадов на биполярных транзисторах. Цифровые схемы. Простейшие логические операции. Логические элементы на диодах. Элементы РТЛ, ДТЛ, ТТЛ. Элементы ЭСЛ, логические элементы с инжекционным питанием. Основные характеристики и параметры логических элементов.	8	4	12	6	30
4	Структуры и схемы полупроводниковых интегральных микросхем на униполярных приборах.	Структура и топология интегрального транзистора с управляющим p-p переходом. Интегральные полевые транзисторы с барьером Шоттки. МОП-транзисторы. МОП-транзисторы с алюминиевым и поликремниевым затворами. Вертикальные транзисторы. Логические элементы на полевых транзисторах. Инвертор на n-канальных МДП транзисторах. Инвертор на КМДП транзисторах. Логические элементы «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ». Логические элементы динамического типа.	4	2	4	6	16
5	Элементы памяти.	Классификация. Разновидности постоянной и динамическая память. ПЗУ, ППЗУ, триггеры. Элементы статической памяти на МДП транзисторах. Элементы памяти на биполярных транзисторах. Элементы статической памяти на МДП транзисторах.	4	2	-	6	12
6	Структура и топология пассивных элементов полупроводниковых интегральных микросхем.	Интегральные резисторы: тонкопленочные, диффузионные, пинчрезисторы. Интегральные конденсаторы. Конденсаторы на основе барьерной емкости p-p-перехода. МДП-конденсаторы	4	2	-	6	12
7	Основные операции технологического маршрута изготовления полупроводниковых интегральных микросхем	Получение полупроводникового кремния. Подготовка подложек для полупроводниковых ИМС. Эпитаксия кремния. Назначение и виды эпитаксии кремния в микроэлектронике. Методы проведения процессов газофазовой эпитаксии кремния. Жидкофазная эпитаксия. Кинетические закономерности эпитаксиальных процессов Применение диэлектрических пленок в микроэлектронике. Методы осаждения диэлектрических слоев диоксида кремния и нитрида кремния из газовой фазы. Термическое окисление кремния. Применение слоёв диоксида кремния, полученных термическим окислением кремния. Кинетические закономерности процессов	20	4	-	6	30

		термического окисления кремния. Модель Дила – Гроува. Диффузионное легирование в планарной технологии. Назначение процессов локальной диффузии в планарной технологии. Методы проведения диффузионного легирования кремния. Кинетические закономерности процессов диффузионного легирования кремния. Ионное легирование в планарной технологии. Назначение процессов ионного легирования в планарной технологии. Методы проведения ионного легирования кремния. Кинетические закономерности процессов ионного легирования. Литография в микроэлектронике. Назначение процессов литографии в планарной технологии. Этапы литографического процесса в микроэлектронике. Формирование межэлементных соединений и защитных покрытий ИМС. Методы нанесения токопроводящих металлических пленок. Этапы формирования межэлементных и межслойных соединений ИМС. Назначение и методы создания защитных покрытий.					
8	Способы изоляции элементов полупроводниковых интегральных схем	Проблемы изоляции элементов в ИМС. Изоляция биполярных транзисторных структур. Самоизоляция МДП-транзисторов. Паразитный МОП-транзистор. Методы изоляции биполярных транзисторных структур. Изоляция интегральных транзисторов обратнo смещённым p-n переходом. Биполярные структуры полупроводниковых ИМС с диэлектрической изоляцией. Комбинированная изоляция. Изоляция пассивных элементов. Эффект тиристорного защелкивания	6	2	2	6	16
9	Основные тенденции в развитие микроэлектроники и наноэлектроники	Физические и технологические ограничения миниатюризации изделий микроэлектроники. 3-D схемы. Представление о функциональной электроники. Микроэлектромеханические системы	4	-	-	6	10
		За 6 семестр	54	18	18	54	144
10	Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом	Энергетическое состояние атомов и молекул. Энергетические состояния атомов и молекул. Квантовые числа. Вращательные и колебательные уровни. Мультиплетное расщепление уровня. Энергетические уровни молекул. Уширение спектральных линий. Естественное уширение. Доплеровское уширение. Уширение вследствие столкновений. Уширение за счёт неоднородностей среды. Квантовые переходы. Матричный элемент. Дипольное приближение. Вероятность перехода. Правила отбора для электронных переходов. Спонтанное и вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. Виды излучений и поглощений. Излучательные и безизлучательные	8	8	-	8	24

		переходы. Связь между коэффициентами Эйнштейна. Рассеяние света. Механизмы рассеяния. Рэлеевским рассеянием Комбинационным рассеянием Стоксово и антистоксово смещение.					
11	Устройство и принцип действия лазеров.	Усиление и генерация электромагнитного излучения. Принцип работы усилителей и квантовых генераторов. Инверсия населенностей. Отрицательная температура. Закон Бугера-Ламберта. Положительная обратная связь. Характеристики лазерного излучения. Возбуждение активного вещества (накачка). Методы накачки. Условия инверсной населенности в полупроводниках. Уравнения кинетики изменения населённости уровней в многоуровневых квантовых системах. Условия инверсии населённости. Методы накачки для полупроводниковых лазеров. Оптические резонаторы. Свойства плоского оптического резонатора. Добротность резонаторов. Эталон Фабри – Перо как частотный анализатор спектральных линий. Оптические резонаторы со сферическими зеркалами. Конфокальный резонатор. Гауссовы пучки. Потери в оптических резонаторах. Устойчивые и неустойчивые оптические резонаторы. Нестационарная генерация, модуль добротности и синхронизация мод. Модуляция добротности резонатора. Гигантские импульсы. Методы модуляции добротности. Синхронизация мод. Электрооптические модуляторы. Газовые лазеры. Акустооптические модуляторы. Голография.. Условия самовозбуждения и насыщение усиления. Пороговая энергия накачки по генерации. Насыщение усиления. Одномодовая и многомодовая генерация.	8	8	4	16	36
12	Энергетическая структура полупроводниковых кристаллов	Энергетические состояния в полупроводниковых кристаллах. Зоны Бриллюэна. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Свойства полупроводников различного состава. Оптическое поглощение в кристаллах. Фундаментальное поглощение. Экситонные эффекты, влияющие на край поглощения при прямых и не прямых переходах. Решеточное поглощение. Примесное поглощение. Поглощение свободными носителями заряда. Оптические переходы в полупроводниках. Оптические переходы в прямозонных и непрямозонных полупроводниках. Люминесценция в полупроводниках. Механизмы излучательной рекомбинации. Квантовый выход и эффективность люминесценции. Связь спектров поглощения и люминесценции. Квантоворазмерные	10	12	-	15	35

		структуры. Квантовые ямы, нити и точки. Собственные значения энергии в квантовых ямах, нитях и точках. Структуры с двумерным электронным газом. Оптические и фотоэлектрические явления в квантоворазмерных структурах. Полупроводниковые гетеропереходы и инжекционная электролюминесценция. Электролюминесценция. Гетеропереходы в полупроводниках. Эффект односторонней инжекции. Эффект сверх инжекции. Эффект широкозонного окна. Фотоэлектрический эффект в однородных кристаллах. Фоторезистивный эффект. Фотодиффузионный и фотомагнитный эффекты. Фотовольтаический эффект. Квантовые ямы, нити и точки и современные направления развития приборов на их основе.					
13	Полупроводниковые приборы квантовой и оптической электроники	Светодиоды. Общая характеристика и особенность полупроводниковых лазеров и светодиодов. Светодиоды на основе полупроводников с прямой и непрямой структурой энергетических зон. Активные материалы. Характеристики СИД. Гетеросветодиоды. Электролюминесцентные экраны. Полупроводниковые лазеры. Требования к активным материалам. Лазер на гомопереходе. Инжекционные лазеры на двойной гетероструктуре, их характеристики. Полосковые гетеролазеры. Фотовольтаический эффект в полупроводниковых структурах. Фотодиоды. Принцип работы р-і-п-фотодиода. Лавинные умножители. Фототриоды. Современное развитие полупроводниковых лазеров, светодиодов и фотоприемников	6	4	14	13	37
14	Волноводная оптоэлектроника	Геометрическая и волновая оптика. Поляризация электромагнитных волн. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. Понятие когерентности. Интерферометр Фабри - Перо. Поляризация электромагнитных волн. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. Волноводный эффект. Параметрическое преобразование и параметрическая генерация света. Вынужденное комбинационное рассеяние Мендельштамма-Бриллюэна. Оптический пробой. (Самофокусировка света). Характеристика и особенность оптической связи. Оптроны как структурные элементы оптоэлектроники. Типы оптронов.	4	4	-	11	19
		За 7 семестр	36	36	18	63	180
Итого			90	54	36	117	324

5.2 Перечень лабораторных работ

Укажите перечень лабораторных работ:

Лабораторная работа № 1. Исследование параметров полупроводникового стабилизатора напряжения.

Лабораторная работа № 2. Статические характеристики и параметры базовой схемы элемента транзисторнотранзисторной логики.

Лабораторная работа № 3. Изучение работы операционного усилителя.

Лабораторная работа № 4. Усилитель низкой частоты на полевом транзисторе.

Лабораторная работа № 5. Исследование характеристик твёрдотельных лазеров, работающих по трёхуровневой схеме, методом численного эксперимента.

Лабораторная работа № 6. Измерение постоянной времени фоторезистора.

Лабораторная работа № 7 Исследование диаграммы направленности светоизлучающих диодов.

Лабораторная работа № 8 Исследование статических характеристик транзисторной оптоэлектронной пары.

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выполнение курсового проекта в 6 семестре для очной формы обучения.

Примерные темы курсового проекта: «Проектирование элемента «2И – НЕ» ТТЛ», «Проектирование интегрального n -канального МОП инвертора с поликремневым затвором.»

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:

1. Анализ возможных способов реализации разрабатываемого элемента на уровне электрической схемы и структурном уровне. Обосновывается выбор базовой схемы и базовой технологии изготовления ИС.
2. Анализ работы электрической схемы.
3. Расчет активных элементов ИС.
4. Расчет и пассивных элементов Ис.
5. Разработка топологии изделия.
6. Разработка комплекта фотошаблонов.
7. Разработка профильной схемы технологического маршрута ИМС.

Курсовой проект включают в себя графическую часть и расчетно-пояснительную записку.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-4	<u>Знать</u> основы технологии материалов оптических и оптико-электронных, материалов, узлов и устройств.	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы при защите курсового проекта	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<u>Уметь</u> критически оценивать достоинства, недостатки и области возможного применения новых научных и технических разработок, реализованных в различных типах электронных приборов, лазеров, фотоизлучателей и фотоприемников.	Решение стандартных практических задач, написание курсового проекта, выполнение лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<u>Владеть</u> навыками практического исследования приборов и устройств оптоэлектроники.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области, выполнение плана работ по разработке курсового проекта, выполнение лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ПК-6	<u>Знать</u> основы технологических процессов изготовления материалов, узлов и устройств микроэлектроники и квантовой электроники на базе нанотехнологий.	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы при защите курсового проекта	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<u>Уметь</u> выполнять критический анализ результатов исследований в области микроэлектроники и квантовой электроники.	Решение стандартных практических задач, написание курсового проекта, выполнение лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<u>Владеть</u> представлением о месте электроники,	Решение прикладных задач в конкретной предметной области, выполнение плана	Выполнение работ в срок, предусмотренный в	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в

	оптической и квантовой электроники в современной науке и технике, и областях применения соответствующих приборов.	работ по разработке курсового проекта, выполнение лабораторных работ	рабочих программах	рабочих программах
--	---	--	--------------------	--------------------

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6, 7 семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:

«отлично»;

«хорошо»;

«удовлетворительно»;

«неудовлетворительно».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
ПК-4	<u>Знать</u> основы технологии материалов оптических и оптико-электронных, материалов, узлов и устройств.	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов
	<u>Уметь</u> критически оценивать достоинства, недостатки и области возможного применения новых научных и технических разработок, реализованных в различных типах электронных приборов, лазеров, фотоизлучателей и фотоприемников.	Решение стандартных практических задач	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	<u>Владеть</u> навыками практического исследования приборов и устройств оптоэлектроники.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ПК-6	<u>Знать</u> основы технологических процессов изготовления материалов, узлов и устройств микроэлектроники и квантовой электроники на базе	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов

нанотехнологий.						
<u>Уметь</u> выполнять критический анализ результатов исследований в области микроэлектроники и квантовой электроники..	Решение стандартных практических задач	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены	
<u>Владеть</u> представлением о месте электроники, оптической и квантовой электроники в современной науке и технике, и областях применения соответствующих приборов..	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены	

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Какие знаете способы описания электромагнитного излучения?

Ответ: Световой луч, электромагнитная волна, фотонная.

2. В каком случае квантовый переход называется оптическим и какому подчиняется правилу?

Ответ: Переходы с испусканием или поглощением кванта света называются оптическими.

$$W_{ba} = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{ba}|^2 \delta(E_b - E_a) t$$

$$M_{ba} = V_{ba} + \sum_{n_1} \frac{V_{bn_1} V_{n_1a}}{E_a - E_{n_1}} + \sum_{n_1} \frac{V_{bn_2} V_{n_2n_1} V_{n_1a}}{(E_a - E_{n_1})(E_a - E_{n_2})} + \dots$$

3. Используя диаграммы записать выражение для матричного элемента перехода. (Ограничиться двумя первыми членами).

Ответ:

$$M_{ba} = V_{ba} + \sum_{n_1} \frac{V_{bn_1} V_{n_1a}}{E_a - E_{n_1}}$$

4. Какой уровень называется метастабильным и какое время жизни атомов в этом состоянии?

Ответ:

$$\delta t \approx \frac{\hbar}{\delta E}$$

5. Назовите и объясните характеристики спонтанного излучения.

Ответ: Электромагнитное излучение обусловленное спонтанными переходами в коллективе атомов называются спонтанным излучением. Спонтанное излучение ненаправлено, некогерентно, неполяризовано и монохроматично.

$$dW_{mn}^{спонта} = A_{mn} dt$$

6. Вынужденные квантовые переходы? Запишите выражения для вероятности вынужденного испускания и вынужденного поглощения.

Ответ: Вынужденные квантовые переходы переходы системы из одного квантового состояния в другое под действием внешнего возмущения.

$$dW_{nm}^{погл} = B_{nm} \rho(\omega) dt$$

$$dW_{ml}^{инд} = B_{ml} \rho(\omega) dt$$

7. Свойства фотона при вынужденном испускании?

Ответ: Имеет одинаковую частоту, фазу, направление распространения и поляризацию с фотоном который индуцировал процесс.

8. Запишите связь между коэффициентами Эйнштейна для индуцированных и спонтанных переходов. (Для вырожденных и невырожденных уровней).

Ответ:

$$g_m B_{mn} = g_n B_{nm}$$

$$A_{mn} = B_{mn} \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^3}$$

9. Объяснить «естественную ширину» спектральной линии.

Ответ: Причина принцип неопределенности

$$\Delta E = \hbar / \tau$$

$$g_L(\omega) = \frac{\Delta \omega}{2\pi} \frac{1}{(\omega_0 - \omega)^2 + (\Delta \omega / 2)^2},$$

$$\Delta \omega = A_{mn}$$

ширина линии

10. Спектр излучения при однородном уширении описывается гаусовской кривой?

Ответ: Да

Нет

11. Какой кривой описывается спектр излучения при неоднородном уширении спектральных линий?

Ответ: Гаусовской

12. Уширение спектральной линии за счет столкновений - это

Ответ:

- а) однородное уширение;
б) неоднородное уширение.

13. Дайте определение однородного и неоднородного уширения спектральных линий. Приведите примеры.

Ответ: Если линии отдельного атома и системы в целом уширяются одинаково однородное уширение. (естественное уширение, уширение за счет релаксации и столкновений). Уширение называется не однородным если резонансная частота отдельных атомов не совпадает и распределяется в некоторой полосе частот приводя к уширению линии поглощения системы в целом. (доплеровское уширение и неоднородности среды).

14. Запишите условия для Релеевского рассеяния.

Ответ:

$$\hbar k \ll p_{\text{электр}} \quad \hbar \omega = \hbar \omega', \quad \alpha_1 \neq \alpha_2, \quad k_1 \neq k_2, \\ \text{При } |k_1| = |k_2|$$

15. В каком диапазоне наблюдается эффект Комптона? Объясните это явление.

Ответ:

$$\hbar k \cong p_{\text{электр}} \quad \hbar \omega - \hbar \omega' = \Delta E \\ \Delta E = f(\alpha) \quad \text{мало} \quad \text{эффект упругого столкновения двух частиц.}$$

16. Интенсивность антистоксова рассеяния больше интенсивности стоксова .

Ответ: а) да

б) нет

17. Записать закон Бугера-Ламберта.

Ответ:

$$I_{\omega}(z) = I_{\omega}(0) \exp - k_{\omega} z, \quad k_{\omega} = \frac{\hbar \omega n B_{12}}{c} g(\omega) \left(N_1 - \frac{g_1}{g_2} N_2 \right)$$

18. Объяснить явление «просветления среды».

Ответ:

$$I_{\omega}(z) = I_{\omega}(0) \exp - k_{\omega} z \quad k_{\omega} = 0 \left(N_1 - \frac{g_1}{g_2} N_2 \right) = 0$$

19. Что такое инверсия населенностей? Записать условие инверсии для

вырожденных и невырожденных уровней.

Ответ:

$$\frac{N_1}{g_1} < \frac{N_2}{g_2}, N_1 < N_2$$

20. Какие три условия необходимы для квантового усиления?

Ответ: 1 Наличие двух уровней энергии E_1 и E_2 разделенных расстоянием $\hbar\omega$, 2 $N_2 > N_1$ 3 Усиление за счет излучения больше потерь $\alpha > \beta$

21. Для чего в квантовых генераторах используют «положительную обратную связь»?

Ответ: Для превращения усилителя в генератор.

22. Явление насыщения – это

Ответ:

а)выравнивание населенностей уровней;

б)инверсия населенностей достигает своего максимального значения.

23. Объяснить термин «накачка». Перечислите методы накачки.

Ответ: Процесс возбуждения активной среды с целью получения инверсной заселенности называется накачкой. Оптическая, газоразрядная, сортировка частиц, инжекция неосновных носителей через р-п переход, возбуждение частиц с высокой энергии, химическая накачка, газодинамическая.

24. Объяснить метод сортировки атомных и молекулярных пучков в пространстве.

Ответ: Взаимодействие с электрическим и магнитным полем различен для возбужденных и не возбужденных атомов.

25. Записать уравнения баланса для двухуровневой схемы.

Ответ:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dN_1}{dt} &= (A_{21} + \rho_{12}B_{21})N_2 - \rho_{12}B_{12}N_1 = 0 \\ \frac{dN_2}{dt} &= \rho_{12}B_{12}N_1 - (A_{21} + \rho_{12}B_{21})N_2 = 0 \\ N_1 + N_2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

26. Квантовый генератор с оптической накачкой по двухуровневой схеме работать

Ответ:

а)может;

б)не может.

27. Почему пороговая плотность накачки по инверсии меньше пороговой плотности для генерации?

Ответ: За счет потерь $N_2 > N_1$

28. В чем преимущество 4-уровневой схемы над 3-уровневой?

Ответ: Инверсия достигается при меньших энергиях накачки.

29. Запишите выражение для частоты собственной моды резонатора.

Ответ:

$$\frac{1}{\lambda_{mq}} = \sqrt{\left(\frac{m}{2L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{2L_2}\right)^2 + \left(\frac{q}{2L_3}\right)^2}$$

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

Задача 1. Боровская модель атома водорода и энергетические уровни в атоме водорода. Опишите модель атома Бора? Почему электронные орбиты могут иметь лишь определенный радиус? Объясните, каким образом это приводит к появлению энергетических уровней в атоме, и укажите какую роль эти уровни играют в спектре поглощения водорода? Энергетический уровень орбиты наименьшего радиуса (т.е. $n=1$) в атоме водорода составляет 13,6 эВ. С какой длиной волны излучения связан переход электрона с орбиты $n=3$ на орбиту $n=1$?

Задача 2. Процесс рекомбинации означает переход электронов с более высоких энергетических уровней зоны проводимости на более низкие энергетические уровни валентной зоны. Такие переходы сопровождаются выделением квантов света, т.е. фотонов. Это явление называемое излучательной рекомбинацией лежит в основе работы светодиодов. Какие полупроводники можно использовать чтобы получить излучение с длиной волны $\lambda=0,38-0,78\text{мкм}$?

Задача 3. Определить температуру, при которой в твердом n/p вероятность найти электрон с энергией 0,5 эВ над уровнем Ферми равна 2%?
 $T=1490\text{К}$

Задача 4. Дать краткое понятие запрещенной зоны и уровня Ферми применительно к беспримесному n/p . Ширина запрещенной зоны $\sim 0,5$ эВ. Вычислить вероятность заполнения электроном уровня вблизи дна зоны проводимости при температурах $T=0\text{К}$ и $T=290\text{К}$. Показать, будет ли увеличиваться эта вероятность при указанных выше температурах, если на n/p действует электромагнитное излучение а). с длиной волны 1,0 мкм, б). с длиной волны 2,0 мкм.

Задача 5. Рассмотреть электрон с нулевой потенциальной энергией в одномерной потенциальной яме в пределах $x=0$ и $x=a$. Вне этих пределов

потенциал равен бесконечности. Вывести выражение для уровней потенциальной энергии этого электрона.

Задача 6. Найдите значение волновой функции Ψ , описывающее состояние электрона в одномерном потенциальном ящике длиной L . Предполагается, что высота потенциальных барьеров на стенках ящика в точках $x=0$ и $x=a$ бесконечна. Показать, что энергия, которую может иметь электрон в таких системах квантуется. Получить выражение для энергии электрона в случае трехмерной модели потенциального ящика.

Задача 7. Оценить минимальную мощность лампы-вспышки, необходимую для накачки твердотельного лазера. Число активных частиц в кристалле $n=10^{19} \text{ см}^{-3}$, объем кристалла 10 см^3 . Время жизни частиц на верхнем рабочем уровне $\tau_{\text{сн}}=3 \cdot 10^{-3} \text{ с}$. Середина полосы, в которую происходит основное поглощение излучения источника накачки, $\nu=6 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$. Принять КПД лампы накачки 100%. Инверсная перенаселенность наступает, если на верхний рабочий уровень перейдет больше половины активных частиц.

Задача 8. Если кристалл рубина освещать светом с длиной волны 550 нм, можно ли получить излучение на длине волны 693,3 нм? Объяснить физический механизм, который обуславливает это явление.

Задача 9. Вычислить энергию фотонов:

- а). в ультрафиолетовой области спектра ($\lambda=330$ и 250 нм)
- б). желтого света ($\lambda=589 \text{ нм}$)
- с). красного света ($\lambda=644 \text{ нм}$).

Свет падает на поверхность натрия, работа выхода фотоэлектронов которого равна $2,11 \text{ эВ}$. Найти максимальные скорости фотоэлектронов, если длины волн падающего света принимают заданные значения.

Задача 10. Рассчитать Q_p , добротность и время жизни фотона τ_p в резонаторе Фабри-Перо с плоскими зеркалами. Расстояние между зеркалами $L=1 \text{ м}$. В резонаторе возбуждается один основной тип колебаний TEM_{000} , образованная двумя бегущими навстречу друг другу плоскими волнами ($\lambda=0,6 \text{ мкм}$). Среда заполняющая резонатор, слабо поглощающая (коэффициент поглощения $\beta=0,001 \text{ см}^{-1}$). (эти потери могут быть связаны с процессом рассеивания в среде, не резонансным поглощением и т.д.) Коэффициент отражения каждого из зеркал $r=95\%$. Диаметр зеркал много больше диаметра светового пучка, поэтому дифракционными потерями можно пренебречь.

Задача 11. Сложный объектив состоит из двух линз, одна из которых сделано из стекла с коэффициентом преломления $n_1=1,52$, второе с $n_2=1,6$. Линзы склеены канадским бальзамом, с $n_3=1,54$. Считая углы падения света

на поверхности линз малыми, определить потери света в объективе из-за отражений. Сравнить эти потери со случаем, когда обе линзы разделены воздушной прослойкой.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач (минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1. Объемный резонатор используют в диапазоне

Ответ:

- а) 10^9 - 10^{11} Гц;
- б) 10^{14} - 10^{15} Гц;
- в) 10^{17} - 10^{18} Гц.

2. Добротность объемного резонатора выше добротности оптического резонатора?

Ответ:

Да

Нет

32. Оптический резонатор – это

Ответ:

- а) **многомодовый резонатор;**
- б) **одномодовый резонатор.**

3. Добротность оптического резонатора ниже добротности спектральной линии?

Ответ:

а) да

б) **нет**

4. Какие колебания оптического резонатора называются аксиальными и неаксиальными?

Ответ: Колебания распространяющиеся по оптической оси резонатора называются оксиальными.

5. Какие потери оптического резонатора называют полезными:

Ответ:

- а) дифракционные потери;
- б) **потери на излучение;**
- в) **потери в активном веществе.**

6. Преимущества и недостатки конфокального резонатора.

7. Записать условие устойчивости резонатора.

Ответ:

$$0 \leq \left(\frac{L}{R_1} - 1 \right) \left(\frac{L}{R_2} - 1 \right) \leq 1$$

8. Объяснить особенности кольцевого резонатора.

9. Записать условие самовозбуждения квантового генератора.

Ответ:

$$\hbar\omega B_{mn}g(\omega)\left(\frac{g_n}{g_m}N_m - N_n\right) \geq \frac{\omega}{Q}$$

10. Зарисуйте условие насыщения поглощения для неоднородно уширенной спектральной линии.

11. Для каких колебаний в оптическом резонаторе в первую очередь будет выполняться условие самовозбуждения?

Ответ: Оксиальных

12. В каком резонаторе будут потери на дифракцию меньше в плоском или в конфокальном при одинаковой величине числа Френеля?

Ответ: Конфокальном

13. Что такое режим регулярных пичков? Он возникает при одномодовом или при многомодовом режиме генерации?

Ответ: При не стационарной работе генератора возникает регулярная убывающая по времени последовательность световых импульсов. Возникает в случае одномодовой работе генератора.

14. За счет чего реализуется импульсный режим работы генератора (гигантские импульсы)?

Ответ: Модуляция добротности.

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Не предусмотрено учебным планом

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену

Укажите вопросы для экзамена

Вопросы для экзамена

1. Способы описания электромагнитного излучения. Объяснить понятия «плоской монохроматической волны», «поляризованной волны».

2. Энергетические состояния атомов и молекул.

3. Квантовые переходы. Матричный элемент перехода.

4. Спонтанное и вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна.

5. Объяснить физический смысл коэффициентов Эйнштейна. Связь между коэффициентами Эйнштейна.

6. Энергетический спектр. Явления приводящие к уширению

спектральных линий. Однородное и неоднородное уширение.

7. Рассеяние света и двухфотонное поглощение.
8. Принцип работы квантовых усилителей и генераторов
9. Закон Бугера-Ламберта. Принцип работы квантовых усилителей и генераторов
10. Методы возбуждения активного вещества.
11. Кинетика заполнения энергетических состояний. Двухуровневые схемы.
12. Трех- и четырехуровневые схемы.
13. Объемные и открытые резонаторы. Одномодовый и многомодовый резонатор. Добротность и потери в резонаторах.
14. Конфокальный резонатор и резонаторы с произвольными сферическими зеркалами. Диаграмма условия устойчивости оптических резонаторов.
15. Кольцевой резонатор и резонатор с брегговским зеркалом
16. Условие самовозбуждения и насыщение усиления.
17. Нестационарная генерация, модуляция добротности и синхронизация мод.
18. Энергетические состояния в полупроводниковых кристаллах. Прямозонные и непрямозонные полупроводники
19. Оптические переходы в полупроводниках
20. Оптическое поглощение в кристаллах полупроводников.
21. Люминесценция. Условия инверсии и усиления в полупроводниках
22. Связь между оптическим поглощением и люминесценцией.
23. Механизмы излучательной рекомбинации в полупроводниках.
24. Эффективность люминесценции и без излучательная рекомбинация.
25. Фотоэлектрические эффекты. Фоторезистивный эффект.
26. Квантоворазмерные структуры: квантовые ямы, нити и точки.
27. Полупроводниковые лазеры. Общая характеристика и особенности.
28. Инжекционные ДГС-лазеры
29. Фотовольтаические эффекты в неоднородных структурах.
30. p-i-n и лавинные фотодиоды.

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 6 баллов.

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 10 баллов

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 баллов.

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Введение. Виды классификации интегральных микросхем	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
2	Общие сведения о планарно-эпитаксиальной технологии полупроводниковых интегральных микросхем.	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
3	Биполярные интегральные микросхемы.	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
4	Структуры и схемы полупроводниковых интегральных микросхем на униполярных приборах.	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
5	Элементы памяти.	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
6	Структура и топология пассивных элементов полупроводниковых интегральных микросхем.	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
7	Основные операции технологического маршрута изготовления полупроводниковых интегральных микросхем	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
8	Способы изоляции элементов полупроводниковых интегральных схем	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
9	Основные тенденции в развитие микроэлектроники и нанoeлектроники	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
10	Взаимодействие	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа,

	электромагнитного излучения с веществом		защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
11	Устройство и принцип действия лазеров.	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
12	Энергетическая структура полупроводниковых кристаллов	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
13	Полупроводниковые приборы квантовой и оптической электроники	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту
14	Волноводная оптоэлектроника	ПК-4, ПК-6	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита по курсовому проекту

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микроэлектронная техника: Учебное пособие М.: Высш. шк. 2005.- 622с.;
2. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. , перераб. и доп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 488 с.: ил..2001, печатн.
3. Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И.. Микроэлектроника. учеб. пособие для вузов М.: Высш. шк. 1986. 464 с.
4. Аваев Н.А., Наумов Ю.Е., Фролкин М.Т. Основы микроэлектроники. Учебник для вузов. М.:Радио и связь. 1991. 288 с
5. Коротков Л.Н., Сысоев О.И. Микроэлектроника: курсовое проектирование Воронеж, ВГТУ, 2011,- 124 (2,1 М, 6,7 пл)
6. Коледов Л.А. Технология и конструирование микросхем, микропроцессоров и микросборок. М.: Радио и связь, 1989.
7. Березин А.С., Мочалкина О.Р. Технология и конструирование интегральных микросхем. М.: Радио и связь, 1992.
8. Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника. – М.: изд-во Высшая школа, 2001.-573с.
10. Звелто О. Принципы лазеров. М.: «Мир», 1984.-400с.
11. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – М.: «Советское радио», 1989.-360с..
12. Страховский Г.М., Успенский А.В. Основы квантовой электроники. – М.: «Высшая школа», 1979.-303с..
13. Тарасов Л.В. Введение в квантовую оптику. – М.: «Высшая школа», 1987.-304с..
14. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. – М.: изд-во Наука, 1971.-376с..
15. Рябов С.Г., Торопкин Г.Р., Усольцев И.Ф. Приборы квантовой электроники. – М.: «Радио и связь», 1985.-280с.

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для проведения лабораторных занятий необходима аудитория, оснащенная стендами для проведения лабораторных работ, компьютерный класс. (аудитории 226, 226а первого корпуса ВГТУ)

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Микроэлектроника и оптоэлектроника» читаются

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполняется курсовой проект.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета _____. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны своевременно и в установленные сроки.

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой курсового проекта, защитой курсового проекта.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Лабораторная работа	Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомиться с соответствующим разделом учебника, проработать дополнительную литературу и источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом с оценкой, экзаменом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.
--	---

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
----------	-----------------------------	----------------------------	--